МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Директор департамента образования
_____ П. Е. Троян
«___» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Электроника

Уровень образования: **высшее образование - бакалавриат**
Направление подготовки / специальность: **11.03.01 Радиотехника**
Направленность (профиль) / специализация: **Радиотехнические средства передачи, приема и обработки сигналов**
Форма обучения: **заочная**
Факультет: **ЗиВФ, Заочный и вечерний факультет**
Кафедра: **ТОР, Кафедра телекоммуникаций и основ радиотехники**
Курс: **2**
Семестр: **3, 4**
Учебный план набора 2016 года

Распределение рабочего времени

№	Виды учебной деятельности	3 семестр	4 семестр	Всего	Единицы
1	Лекции	10	0	10	часов
2	Практические занятия	8	4	12	часов
3	Всего аудиторных занятий	18	4	22	часов
4	Самостоятельная работа	90	95	185	часов
5	Всего (без экзамена)	108	99	207	часов
6	Подготовка и сдача экзамена	0	9	9	часов
7	Общая трудоемкость	108	108	216	часов
				6.0	З.Е.

Контрольные работы: 4 семестр - 2
Экзамен: 4 семестр

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шелупанов А.А.
Должность: Ректор
Дата подписания: 23.08.2017
Уникальный программный ключ:
c53e145e-8b20-45aa-9347-a5e4dbb90e8d

Томск 2018

Согласована на портале № 39832

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры
протокол № 54 от «15» 6 2018 г.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 11.03.01 Радиотехника, утвержденного 06.03.2015 года, рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ТУ «___» _____ 20__ года, протокол №_____.

Разработчики:

профессор каф. ТУ	_____	В. А. Шалимов
профессор каф. ТУ	_____	А. М. Заболоцкий

Заведующий обеспечивающей каф. ТУ	_____	Т. Р. Газизов

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:

Декан ЗиВФ	_____	И. В. Осипов
Заведующий выпускающей каф. ТОР	_____	А. А. Гельцер

Эксперты:

доцент кафедры ТУ	_____	А. Н. Булдаков
Доцент кафедры телекоммуникаций и основ радиотехники (ТОР)	_____	С. И. Богомолов

Согласована на портале № 39832

1. Цели и задачи дисциплины

1.1. Цели дисциплины

Целью преподавания дисциплины является изучение студентами принципов работы, параметров, вольт-амперных характеристик, элементной базы, применяемой в многоканальных телекоммуникационных системах, телевизионной, радиорелейной, тропосферной, космической и радиолокационной связи

1.2. Задачи дисциплины

– - изучение принципов действия, характеристик, параметров и особенностей устройства важнейших полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов, используемых в аудиовизуальной технике. К их числу относятся диоды, биполярных и полевые транзисторы, приборы с отрицательной дифференциальной проводимостью, оптоэлектронные и электровакуумные приборы, элементы интегральных схем и основы технологии их производства;

– - изучение главных элементов цифровой и аналоговой схемотехники, выполненных на основе полупроводниковых, электровакуумных и оптоэлектронных приборов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Электроника» (Б1.Б.19) относится к блоку 1 (базовая часть).

Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Электроника, Основы теории цепей, Физика.

Последующими дисциплинами являются: Электроника, Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства, Программирование логических интегральных схем, Цифровые устройства и микропроцессоры.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– ОПК-7 способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

– **знать** - устройство и принцип действия, условные графические обозначения транзисторных ключей, логических элементов «И», «ИЛИ» на дискретных и интегральных компонентах; - устройство и принцип действия, условные графические обозначения усилителей и преобразователей аналоговых электрических сигналов на полевых и биполярных транзисторах, операционных усилителях; - микросхемотехнику, принципы работы базовых каскадов логических элементов цифровых схем.

– **уметь** - объяснять физическое назначение элементов аналоговых и цифровых схем и их влияние на параметры базовых каскадов; - проводить электрические расчеты элементов отдельных каскадов с использованием стандартных пакетов прикладных программ.

– **владеть** - навыками измерения характеристик и параметров цифровых и аналоговых интегральных схем и методами математического моделирования компонентов и схем; - навыками объективной оценки возможностей функциональной электроники.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины

Виды учебной деятельности	Всего часов	Семестры	
		3 семестр	4 семестр
Аудиторные занятия (всего)	22	18	4
Лекции	10	10	0
Практические занятия	12	8	4
Самостоятельная работа (всего)	185	90	95

Согласована на портале № 39832

Проработка лекционного материала	56	56	0
Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	79	0	79
Подготовка к практическим занятиям, семинарам	50	34	16
Всего (без экзамена)	207	108	99
Подготовка и сдача экзамена	9	0	9
Общая трудоемкость, ч	216	108	108
Зачетные Единицы	6.0		

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий

Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины	Лек., ч	Прак. зан., ч	Сам. раб., ч	Всего часов (без экзамена)	Формируемые компетенции
3 семестр					
1 Введение в физику полупроводников.	1	0	6	7	ОПК-7
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	1	2	21	24	ОПК-7
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими переходами и её статические характеристики.	3	3	21	27	ОПК-7
4 Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	2	3	22	27	ОПК-7
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего перехода.	2	0	10	12	ОПК-7
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	1	0	10	11	ОПК-7
Итого за семестр	10	8	90	108	
4 семестр					
7 Классификация логических элементов	0	0	19	19	ОПК-7
8 Схемы логического отрицания на биполярных транзисторах	0	1	24	25	ОПК-7
9 Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)	0	1	26	27	ОПК-7
10 Схема логического отрицания на полевых транзисторах.	0	2	26	28	ОПК-7

Согласована на портале № 39832

Итого за семестр	0	4	95	99	
Итого	10	12	185	207	

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

Содержание разделов дисциплин (по лекциям) приведено в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (по лекциям)

Названия разделов	Содержание разделов дисциплины (по лекциям)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
3 семестр			
1 Введение в физику полупроводников.	Зонная модель твердых тел. Классификация твердых тел (металлы, полупроводники, диэлектрики). Кристаллическая решетка полупроводников. Собственный полупроводник. Энергетическая (зонная) диаграмма собственного полупроводника. Электроны и дырки. Примесные полупроводники. Доноры и акцепторы. Проводимости n- и p-типа. Зонные диаграммы, уровни доноров и акцепторов. Компенсированные полупроводники.	1	ОПК-7
	Итого	1	
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n-переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Классификация переходов. Структура p-n перехода. Понятие нейтральности перехода. Анализ перехода в равновесном состоянии. Анализ перехода в неравновесном состоянии. Статические вольтамперные характеристики идеального диода. Понятие обратного тока диода. Характеристические сопротивления диода. Статические вольтамперные характеристики реальных диодов. Модуляция сопротивления базы. Переходные характеристики диода. Барьерная ёмкость (ёмкость перехода) диода. Диффузионная ёмкость перехода. Односторонние p-n переходы. Контакты металл-полупроводник. Омические контакты. Выпрямляющие контакты.	1	ОПК-7
	Итого	1	
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими переходами и её статические характеристики.	Физические принципы работы биполярных транзисторов. Эквивалентные схемы биполярных транзисторов. Формулы Молла-Эберса. Идеализированные статические и динамические параметры биполярных транзисторов. Схемы включения. Зависимость параметров биполярных транзисторов от температуры и режима. Составные биполярные транзисторы.	3	ОПК-7
	Итого	3	
4 Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её	МДП-транзисторы с изолированным затвором, встроенным и индуцированным каналами. Принцип работы, основные параметры. Статические вольтамперные характеристики для каждого типа	2	ОПК-7

Согласована на портале № 39832

статические характеристики.	полевых транзисторов. Эквивалентные схемы полевых транзисторов.		
	Итого	2	
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего перехода.	Полевые транзисторы с управляющим p-n переходом. Принцип работы, основные параметры. Статические вольт-амперные характеристики для каждого типа полевых транзисторов. Эквивалентные схемы полевых транзисторов.	2	ОПК-7
	Итого	2	
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	Оптоэлектронные приборы: светоизлучающие диоды, фотодиоды, оптопары диодные, транзисторные, теристорные. Принцип работы, основные параметры. Статические вольтамперные характеристики	1	ОПК-7
	Итого	1	
Итого за семестр		10	
Итого		10	

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.

Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи

Наименование дисциплин	№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Предшествующие дисциплины										
1 Электроника	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Основы теории цепей		+	+	+	+	+		+	+	+
3 Физика	+	+		+		+				
Последующие дисциплины										
1 Электроника	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Аналоговые и цифровые быстродействующие устройства			+	+		+	+	+	+	+
3 Программирование логических интегральных схем			+	+	+	+		+	+	+
4 Цифровые устройства и микропроцессоры			+	+	+	+		+	+	+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий представлено в таблице 5.4.

Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

	Виды занятий	Формы контроля

Согласована на портале № 39832

Компетенции	Лек.	Прак. зан.	Сам. раб.	
ОПК-7	+	+	+	Контрольная работа, Экзамен, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения

Не предусмотрено РУП.

7. Лабораторные работы

Не предусмотрено РУП.

8. Практические занятия (семинары)

Наименование практических занятий (семинаров) приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Наименование практических занятий (семинаров)

Названия разделов	Наименование практических занятий (семинаров)	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции
3 семестр			
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n-переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Расчет вольт-амперных характеристик идеализированных переходов при различной температуре.	2	ОПК-7
	Итого	2	
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими переходами и её статические характеристики.	Расчет параметров биполярных транзисторов	3	ОПК-7
	Итого	3	
4 Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	Расчет параметров полевых транзисторов	2	ОПК-7
	Расчет элементов логических схем на полевых транзисторах	1	
	Итого	3	
Итого за семестр		8	
4 семестр			
8 Схемы логического отрицания на биполярных транзисторах	Схемы НЕ на биполярных транзисторах npn, pnp.	1	ОПК-7
	Итого	1	
9 Элементы транзисторно-транзисторной логики	Базовый элемент ТТЛ И-НЕ.	1	ОПК-7
	Итого	1	

Согласована на портале № 39832

(ТТЛ)			
10 Схема логического отрицания на полевых транзисторах.	Схемы ключа на полевых транзисторах.	2	ОПК-7
	Итого	2	
Итого за семестр		4	
Итого		12	

9. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции

Названия разделов	Виды самостоятельной работы	Трудоемкость, ч	Формируемые компетенции	Формы контроля
3 семестр				
1 Введение в физику полупроводников.	Проработка лекционного материала	6	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Итого	6		
2 Физические процессы при контакте разнородных материалов (p-n- переход, контакт металл-полупроводник, гетеропереход).	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	11	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	10		
	Итого	21		
3 Физические процессы в структуре с двумя взаимодействующими переходами и её статические характеристики.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	11	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	10		
	Итого	21		
4 Физические процессы в структуре металл-диэлектрик-полупроводник и её статические характеристики.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	12	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Проработка лекционного материала	10		
	Итого	22		
5 Физические основы управления током канала с помощью управляющего перехода.	Проработка лекционного материала	10	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Итого	10		
6 Фотоэлектрические явления в полупроводниках.	Проработка лекционного материала	10	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Итого	10		
Итого за семестр		90		

Согласована на портале № 39832

4 семестр				
7 Классификация логических элементов	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	19	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Итого	19		
8 Схемы логического отрицания на биполярных транзисторах	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	4	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	20		
	Итого	24		
9 Элементы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ)	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	20		
	Итого	26		
10 Схема логического отрицания на полевых транзисторах.	Подготовка к практическим занятиям, семинарам	6	ОПК-7	Контрольная работа, Тест, Экзамен
	Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса	20		
	Итого	26		
Итого за семестр		95		
	Подготовка и сдача экзамена	9		Экзамен
Итого		194		

10. Курсовой проект / курсовая работа

Не предусмотрено РУП.

11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся

Рейтинговая система не используется.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература

1. Электроника. Часть 1 [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ицкович В. М., Шалимов В. А. - 2016. 209 с. дата доступа 20.06.2018 - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7278 (дата обращения: 19.07.2018).

2. Электроника. Часть 2 [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ицкович В. М., Шалимов В. А. - 2016. 120 с. дата доступа 20.06.2018 - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7279 (дата обращения: 19.07.2018).

3. Электроника [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Коновалов В. Ф. - 2012. 266 с. дата доступа 20.06.2018 - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7314 (дата обращения: 19.07.2018).

Согласована на портале № 39832

12.2. Дополнительная литература

1. 1. Гусев В.Г. Электроника: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 1991. – 622 с. (наличие в библиотеке ТУСУР - 73 экз.)
2. Степаненко И.П. Основы теории транзисторов и транзисторных схем: научное издание. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1977. – 671 с. (81) (наличие в библиотеке ТУСУР - 81 экз.)
3. 4. Жеребцов И.П. Основы электроники. – 5-е изд., перераб. и доп. – Л.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. (53) (наличие в библиотеке ТУСУР - 53 экз.)
4. 5. Аваев Н.А. Основы микроэлектроники: рекомендовано Министерством образования. – М.: Радио и связь, 1991. – 287 с. (87) (наличие в библиотеке ТУСУР - 87 экз.)

12.3. Учебно-методические пособия

12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия

1. Электроника [Электронный ресурс]: Учебно-методическое пособие / Ицкович В. М., Шалимов В. А. - 2016. 76 с. (Пособие рекомендовано к самостоятельным и практическим занятиям) (Дата доступа 20.05.2018) - Режим доступа: https://edu.tusur.ru/publications/7280 (дата обращения: 19.07.2018).

12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. При изучении дисциплины рекомендуется использовать базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, к которым у ТУСУРа есть доступ https://lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh.

12.5. Периодические издания

1. Электроника : научно-технический журнал. Известия ВУЗов/ Министерство образования Российской Федерации (М.), Московский государственный институт электронной техники. - М. : МИЭТ, 1996 - . - ISSN 1561-5405
2. Радиотехника : научно - технический журнал. - М. : Радиотехника . - Журнал выходит с февраль 1937 г
3. Электроника : научно-технический журнал. - М. : Мир . - Журнал выходит с 1961 г
4. Радиофизика и физические основы электроники [Электр.ресурс] : реферативный журнал. Сер. 18. Ж. - М. : ВИНИТИ . - Журнал выходит с 1954 г.

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное обеспечение

13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению дисциплины

13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение для лекционных занятий

Для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория с количеством посадочных мест не менее 22-24, оборудованная доской и стандартной учебной мебелью. Имеются

Согласована на портале № 39832

демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации по лекционным разделам дисциплины.

13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для практических занятий

Лаборатория комплексных информационных технологий в управлении

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 209 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Компьютер Intel с монитором (16 шт.);
- Стол письменный 120 см (18 шт.);
- Доска трёхэлементная;
- Экран рулонный;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение:

- Microsoft Windows XP
- OpenOffice
- TALGAT2016

Учебная лаборатория цифровых устройств и микропроцессоров

учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий практического типа, учебная аудитория для проведения занятий лабораторного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, помещение для курсового проектирования (выполнения курсовых работ), помещение для проведения групповых и индивидуальных консультаций, помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, помещение для самостоятельной работы

634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 218 ауд.

Описание имеющегося оборудования:

- Генераторы: Г3-53 (3 шт.), Г3-112/1 (3 шт.), Г5-54 (6 шт.);
- Осциллографы GOS-620 (6 шт.);
- Макеты (6 шт.);
- Доска аудиторная;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.

Программное обеспечение не требуется.

13.1.3. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы

Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы), расположенные по адресам:

- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.

Состав оборудования:

- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Согласована на портале № 39832

Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.

13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями слуха** предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями зрениями** предусмотрено использование в лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.

При занятиях с обучающимися **с нарушениями опорно-двигательного аппарата** используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.

14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения дисциплины

14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации

Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной компетенций используются оценочные материалы в составе:

14.1.1. Тестовые задания

1. Какие типы полупроводниковых материалов используются при создании p-n переходов:

а) «n» полупроводниковые материалы.

б) «p» полупроводниковые материалы.

в) «i» полупроводниковые материалы.

г) «p-n».

2. Какой полупроводниковый материал обеспечивает наибольшую рабочую температуру:

а) Ge.

б) Si.

в) GaAs.

3.Какой полупроводниковый материал диода обеспечивает наи

большую рабочую частоту:

Согласована на портале № 39832

а) Ge.

б) Si.

в) GaAs.

4 При каком включении диода на p-n переходе выделяется наибольшая мощность:

а) Обратном.

б) Прямом.

в) В области пробоя.

5 Для чего одну из областей p-n перехода выполняют относительно, высокоомной:

а) Для увеличения быстродействия.

б) Для увеличения максимального тока.

в) Для увеличения напряжения пробоя.

6 Как меняется емкость p-n перехода при обратном включении и увеличении запирающего напряжения:

а) Увеличивается.

б) Не меняется.

в) Уменьшается.

7.В области пробоя сопротивление p-n перехода:

а) Rпер→∞.

б) Rпер=0.

в) Rпер неизменно.

8 Для увеличения быстродействия полупроводникового прибора материал p-n перехода:

а) Слабо легируют.

б) Сильно легируют.

в) Выполняют из i полупроводника.

9. При прямом включении p-n перехода сопротивление перехода:

а) Rпер→∞.

б) Rпер=0.

Согласована на портале № 39832

в) Rпер неизменно

.

10. В какой схеме включения биполярные транзисторы имеют максимальный коэффициент усиления по мощности:

а) ОБ.

б) ОК.

в) ОЭ.

11. При каком включении диода на p-n переходе выделяется наименьшая мощность:

а) Обратном.

б) Прямом.

в) В области пробоя.

12. В какой схеме включения биполярные транзисторы имеют максимальное входное сопротивление:

а) ОБ.

б) ОК.

в) ОЭ.

13. В какой схеме включения биполярные транзисторы имеют наилучшие частотные свойства:

а) ОБ.

б) ОК.

в) ОЭ.

14. Диодный оптрон это:

а) Светодиод.

б) Фотодиод.

в) Светои фотодиод в одном корпусе.

15. В каких режимах могут работать фотодиоды:

а) Преобразовывать свет-сигнал.

Согласована на портале № 39832

б) Фотогенераторов.

в) Преобразовывать переменное напряжение в постоянное .

16. Для полевого транзистора с индуцированным «n» каналом в схеме «общий исток» при увеличении отрицательного напряжения на затворе ток стока:

а) Уменьшается.

б) Увеличивается.

в) Остается неизменным.

г) Равен 0.

17. Для полевого транзистора с встроенным «p» каналом в схеме с общим истоком при увеличении отрицательного напряжения на затворе ток стока:

а) Уменьшается.

б) Увеличивается.

в) Не меняется.

18. Из какого полупроводникового материала следует изготовить полевые транзисторы, обладающие максимальным быстродействием:

а) Ge

б) Si

в) nGaAs

г) pGaAs

д) InN (Нитрид индия)

19. Какой из видов полевых транзисторов обладает наименьшей чувствительностью к электростатическому пробою:

а) Полевые транзисторы со встроенным каналом.

б) Полевые транзисторы с индуцированным каналом.

в) Полевые транзисторы с «p-n» переходом.

20. Для управления током стока полевым транзисторам требуется изменять:

а) Ток затвора.

Согласована на портале № 39832

б) Напряжение Uси.

в) Напряжение Uзи.

14.1.2. Экзаменационные вопросы

1. Разрешенные и запрещенные энергетические зоны. Собственная электропроводность полупроводника.

2. Примесная электропроводность полупроводника. Акцепторные примеси. Донорные примеси.

3. Процессы переноса зарядов в полупроводниках. Диффузия носителей заряда. Дрейф носителей заряда.

4. Электрические переходы. Электронно-дырочный переход. Вентильное свойство p-n перехода. Емкость p-n перехода. Виды пробоев p-n перехода.

5. Полупроводниковый диод. Классификация диодов. Основные параметры.

6. Стабилитрон.

7. Варикап.

8. Туннельный диод.

9. Диод Шоттки.

10. Точечный диод.

11. Лавинный диод.

12. Импульсный диод.

13. Биполярный транзистор. Структура и основные режимы работы.

14. Физические процессы в биполярном транзисторе. Основные параметры биполярных транзисторов.

15. Схемы включения транзистора. Схема с общей базой. Схема с общим эмиттером. Схема с общим коллектором. Основные параметры, характеризующие эти схемы включения.

16. Статические характеристики биполярного транзистора.

17. Предельные режимы работы транзистора.

18. Режимы работы усилительных каскадов.

19. Влияние температуры на работу усилительных каскадов. Схема эмиттерной стабилизации. Схема коллекторной стабилизации.

20. Составной транзистор. Схемы составного транзистора.

21. Полевой транзистор. Разновидности полевых транзисторов.

22. Основные параметры полевых транзисторов.

23. Физические процессы в полевом транзисторе с управляющим p-n переходом. Статические характеристики.

24. Структуры полевых транзисторов с изолированным затвором (МДП-транзисторы): со встроенным каналом; с индуцированным каналом.

25. Физические процессы в МДП-транзисторах. Статические характеристики.

26. Схемы включения полевых транзисторов.

27. Формы импульсных сигналов. Параметры, характеризующие импульсный сигнал.

28. Классификация логических элементов. Обозначения логических элементов. Основные параметры логических элементов. Основные характеристики логических элементов.

29. Принципиальная схема ключа на биполярном транзисторе (pnp, npn). Статический режим работы транзисторного ключа. Параметры, характеризующие входную цепь транзисторного ключа. Параметры, характеризующие выходную цепь транзисторного ключа.

30. Переходные процессы в ключевых цепях с биполярными транзисторами (Открывание транзисторного ключа, закрывание транзисторного ключа, временные диаграммы токов и напряжений). Как можно уменьшить время рассасывания, длительности фронта и спада в насыщенном ключе.

31. Принципиальная схема транзисторного ключа с ускоряющей емкостью. Объясните, почему включение конденсатора позволяет сократить время рассасывания, длительности фронта и спада.

32. Принципиальная схема транзисторного ключа с нелинейной обратной связью. Объяснить принцип работы

Согласована на портале № 39832

33. Принципиальная схема ключа на n-канальных МДП-транзисторах. Объяснить принцип работы.

34. Принципиальная схема ключа на p-канальных МДП-транзисторах. Объяснить принцип работы.

35. Принципиальная схема ключа на КМДП-структурах. Объяснить принцип работы.

36. Принципиальная схема логического элемента «И» на диодах. Объяснить принцип работы.

37. Принципиальная схема логического элемента «ИЛИ» на диодах. Объяснить принцип работы.

38. Принципиальная схема логического элемента «ИЛИ» на биполярных транзисторах (pnp, npn). Объяснить принцип работы.

39. Принципиальная схема логического элемента «И» на биполярных транзисторах (pnp, npn). Объяснить принцип работы.

40. Принципиальная схема малосигнального логического элемента ТТЛ. Объяснить принцип работы.

41. Принципиальная схема логического элемента ТТЛ со сложным инвертором. Объяснить принцип работы.

42. Принципиальная схема логического элемента «И-НЕ» на МДП-транзисторах (n-каналом, p- каналом). Объяснить принцип работы.

43. Принципиальная схема логического элемента «ИЛИ-НЕ» на МДП-транзисторах (n-каналом, p- каналом). Объяснить принцип работы.

44. Принципиальная схема логического элемента «И-НЕ» на КМДП-структурах. Объяснить принцип работы.

45. Принципиальная схема логического элемента «ИЛИ-НЕ» на КМДП-структурах. Объяснить принцип работы.

46. h-параметры. Физический смысл коэффициентов. Эквивалентная схема транзистора с учетом h-параметров.

47. y-параметры. Физический смысл коэффициентов. Эквивалентная схема транзистора с учетом y-параметров.

48. Эквивалентные схемы для биполярных и полевых транзисторов.

49. Оптоэлектроника. Внутренний фотоэффект. Внешний фотоэффект.

50. Фотоэлектрические приборы на основе внешнего фотоэффекта. Фотоэлемент. Основные характеристики. Основные параметры.

51. Фотоэлектрические приборы на основе внутреннего фотоэффекта. Фоторезистор. Основные характеристики. Основные параметры.

52. Фотодиод. Способы включения. Принцип действия. Основные характеристики. Основные параметры.

53. Фототранзистор. Принцип действия. Основные характеристики.

54. Светодиод. Структура. Принцип действия.

55. Оптрон.

14.1.3. Темы контрольных работ

Схема логического отрицания на биполярных транзисторах.pnp КР-2

Схема логического отрицания на биполярных транзисторах.npn КР-2

Схема логического отрицания на полевых транзисторах с встроенным p каналом КР-2

Схема логического отрицания на полевых транзисторах с встроенным n каналом КР-2

Схема логического отрицания на полевых транзисторах с встроенным p каналом КР-2

Логическая схема ИЛИ-НЕ на на полевых транзисторах с встроенным p каналом КР-2

Согласована на портале № 39832

Логическая схема ИЛИ-НЕ на на полевых транзисторах с встроенным n каналом КР-2

Логическая схема ИЛИ-НЕ на КМДП структуре КР-2

Логический элемент И-ИЛИ-НЕ на полевых транзисторах с p-n переходом и p каналом КР-2

Логический элемент И-ИЛИ-НЕ на полевых транзисторах с p-n переходом и n каналом КР-2

Логический элемент И на полевых транзисторах с p-n переходом и n каналом КР-2

Логический элемент И на полевых транзисторах с p-n переходом и p каналом КР-2

Логический элемент ИЛИ-НЕ на КМДП структуре КР-2

Логический элемент И-НЕ на КМДП структуре КР-2

Логический элемент И на полевых транзисторах с встроенным p каналом с

Логический элемент И на полевых транзисторах с встроенным p каналом КР-2

Логический элемент И на полевых транзисторах с индуцированным p каналом КР-2

Логический элемент И на полевых транзисторах с встроенным n каналом КР-2

Логический элемент И на полевых транзисторах с индуцированным n каналом КР-2

Логический элемент ИЛИ на полевых транзисторах КМДП типа КР-2

Логический элемент ИЛИ на полевых транзисторах с индуцированным n каналом КР-2

Логический элемент ИЛИ на полевых транзисторах с индуцированным p каналом КР-2

Биполярный транзистор npn в схеме с общей базой КР-1

Биполярный транзистор pnp в схеме с общей базой КР-1

Биполярный транзистор pnp в схеме с общим эмиттером КР-1

Биполярный транзистор npn в схеме с общей базой КР-1

Биполярный транзистор npn в схеме с общим эмиттером КР-1

Полевой транзистор с p-n переходом и n каналом в схеме с общим истоком КР-1

Полевой транзистор с p-n переходом и p каналом в схеме с общим истоком КР-1

Полевой транзистор с встроенным n каналом в схеме с общим истоком КР-1

Полевой транзистор с встроенным p каналом в схеме с общим истоком КР-1

Полевой транзистор с индуцированным n каналом в схеме с общим истоком КР-1

Полевой транзистор с индуцированным p каналом в схеме с общим истоком КР-1

Согласована на портале № 39832

Диодный оптрон КР-1

Транзисторный оптрон КР-1

Светодиоды КР-1

Фотодиоды КР-1

Плоскостные диоды КР-1

Точечные диоды КР-1

Диоды Шотки КР-1

Импульсные диоды КР-1

Диоды СВЧ КР-1

Диоды Ганна КР-1

Опорные диоды КР-1

14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.

Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Категории обучающихся	Виды дополнительных оценочных материалов	Формы контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями слуха	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы	Преимущественно письменная проверка
С нарушениями зрения	Собеседование по вопросам к зачету, опрос по терминам	Преимущественно устная проверка (индивидуально)
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Решение дистанционных тестов, контрольные работы, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету	Преимущественно дистанционными методами
С ограничениями по общемедицинским показаниям	Тесты, письменные самостоятельные работы, вопросы к зачету, контрольные работы, устные ответы	Преимущественно проверка методами исходя из состояния обучающегося на момент проверки

14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной форме;
- в печатной форме с увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- методом чтения ассистентом задания вслух;
- предоставление задания с использованием сурдоперевода.

Согласована на портале № 39832

Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге;
- набор ответов на компьютере;
- набор ответов с использованием услуг ассистента;
- представление ответов устно.

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме увеличенным шрифтом.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в форме электронного документа;
- в печатной форме.

При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.

Согласована на портале № 39832